

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



J1021 U.S. PTO
10/023189

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
21. Dezember 2000 (21.12.2000)

PCT

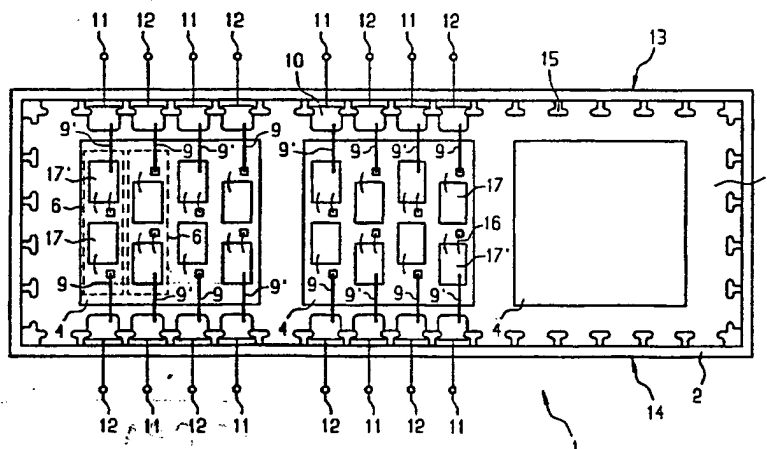
(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 00/77827 A2

- (51) Internationale Patentklassifikation⁷: H01L FÜR LEISTUNGSHALBLEITER MBH & CO.
KG [DE/DE]; Max-Planck-Strasse 5, D-59581
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE00/01254 Warstein-Belecke (DE).
(22) Internationales Anmeldedatum: 20. April 2000 (20.04.2000) (72) Erfinder; und
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): HIERHOLZER, Mar-
tin [DE/DE]; Steffensweg 17, D-59581 Warstein (DE).
(25) Einreichungssprache: Deutsch
(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch (74) Anwalt: MÜLLER & HOFFMANN; Innere Wiener
Strasse 17, 81667 München (DE).
(30) Angaben zur Priorität: 199 27 285.9 15. Juni 1999 (15.06.1999) DE (81) Bestimmungsstaaten (national): JP, KR, US.
(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): EUPEC EUROPÄISCHE GESELLSCHAFT (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT,
BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC,
NL, PT, SE).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: LOW-INDUCTANCE SEMICONDUCTOR COMPONENT

(54) Bezeichnung: NIEDERINDUKTIVES HALBLEITERBAUELEMENT



(57) Abstract: The invention relates to a semiconductor component comprising a housing, a substrate board, at least one ceramic substrate which at least on its upper surface is provided with a metallization (10), and at least two switching elements. The switching elements are mounted on the upper surface of the ceramic substrate in an electrically conductive manner and each have load-current connections and a control connection. According to the invention the semiconductor component comprises several external load-current connecting elements which are positioned on one side of said component as well as on a second side which is opposite the first. The load-current connections of the switching elements are electrically connected via supply wires to the external load-current connecting elements which can present a first and a second supply potential. Two switching elements each are arranged next to each other in such a way that the corresponding supply wires extend substantially parallel to two load-current connecting elements which are assigned to same and present different polarities. This results in compensation of the magnetic fields.

(57) Zusammenfassung: Es wird ein Halbleiterbauelement vorgeschlagen, das ein Gehäuse, eine Trägerplatte, zumindest ein Keramiksubstrat, das zumindest an seiner Oberseite mit einer Metallisierung (10) versehen ist und zumindest zwei Schaltelemente aufweist, vorgeschlagen. Die Schaltelemente sind auf der Oberseite des Keramiksubstrats elektrisch leitend angeordnet

VO 00/77827 A2



Veröffentlicht:

— Ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts.

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

DOCKET NO: MUH-12015
 SERIAL NO: _____
 APPLICANT: Martin Hierholzer

LERNER AND GREENBERG P.A.
 P.O. BOX 2480
 HOLLYWOOD, FLORIDA 33022
 TEL. (954) 925-1100

und verfügen jeweils über Laststromanschlüsse und einen Steueranschluß. Erfindungsgemäß verfügt das Halbleiterbauelement über mehrere externe Laststromanschlußelemente, die auf einer ersten Seite und einer zweiten, der ersten gegenüberliegenden Seite angeordnet sind. Die Laststromanschlüsse der Schaltelemente sind über Zuführungen elektrisch mit den externen Laststromanschlußelementen verbunden, die ein erstes und ein zweites Versorgungspotential aufweisen können. Jeweils zwei Schaltelemente sind derart benachbart angeordnet, daß sich die jeweiligen Zuführungen annähernd parallel zu zwei zugeordneten Laststromanschlußelementen